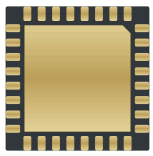
10–1100 MHz GaN パッケージ型パワーアンプ — PSAT ≥ 40 dBm

LCI-PA-10-1100-PS40MIN · 10–1100 MHz · GaN パッケージ型パワーアンプ.

RF 電気特性表の規定値: PSAT ≥ 40 dBm; 電力利得 ≥ 13 dB; PAE ≥ 60 %. RF 測定条件: TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW.



QFN32 5 × 5 mm

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

T_peak ≤ 260 °C

RFin / Vg: 4, 5

RFout / Vd: 20, 21

GND: 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32

パッケージ外形寸法: 5 × 5 × 1 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	10	-	1100	MHz
飽和出力電力	-	40	-	-	dBm
電力利得	-	13	-	-	dB
電力付加効率	-	60	-	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	±0.5	dB

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン電圧	-	-	-	-	28	V
ゲート電圧	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大入力電力	-	-	-	27	dBm

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	5 × 5 × 1	mm

ピン配置

記号	ピン番号	機能
GND	1,8,9,16,17,24,25,32	-
NIC	2,3,6,7,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23, 26,27,28,29,30,31	内部未接続。接地可能。
RFin	4,5	RF入力／ゲート・バイアス
RFout	20,21	RF出力／ドレイン・バイアス

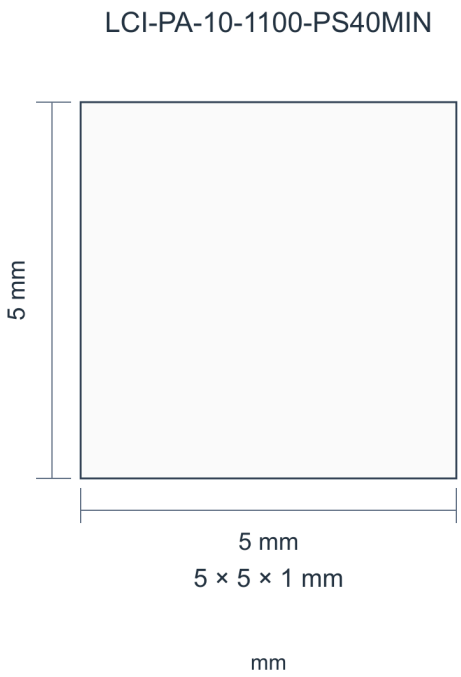
現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

実装上の注意

QFN32 5 × 5 mm ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF T_peak ≤ 260 °C RFin / Vg: 4, 5 RFout / Vd: 20, 21 GND: 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32 パッケージ下面の露出パッドはRFおよびDCグランドに接続してください。

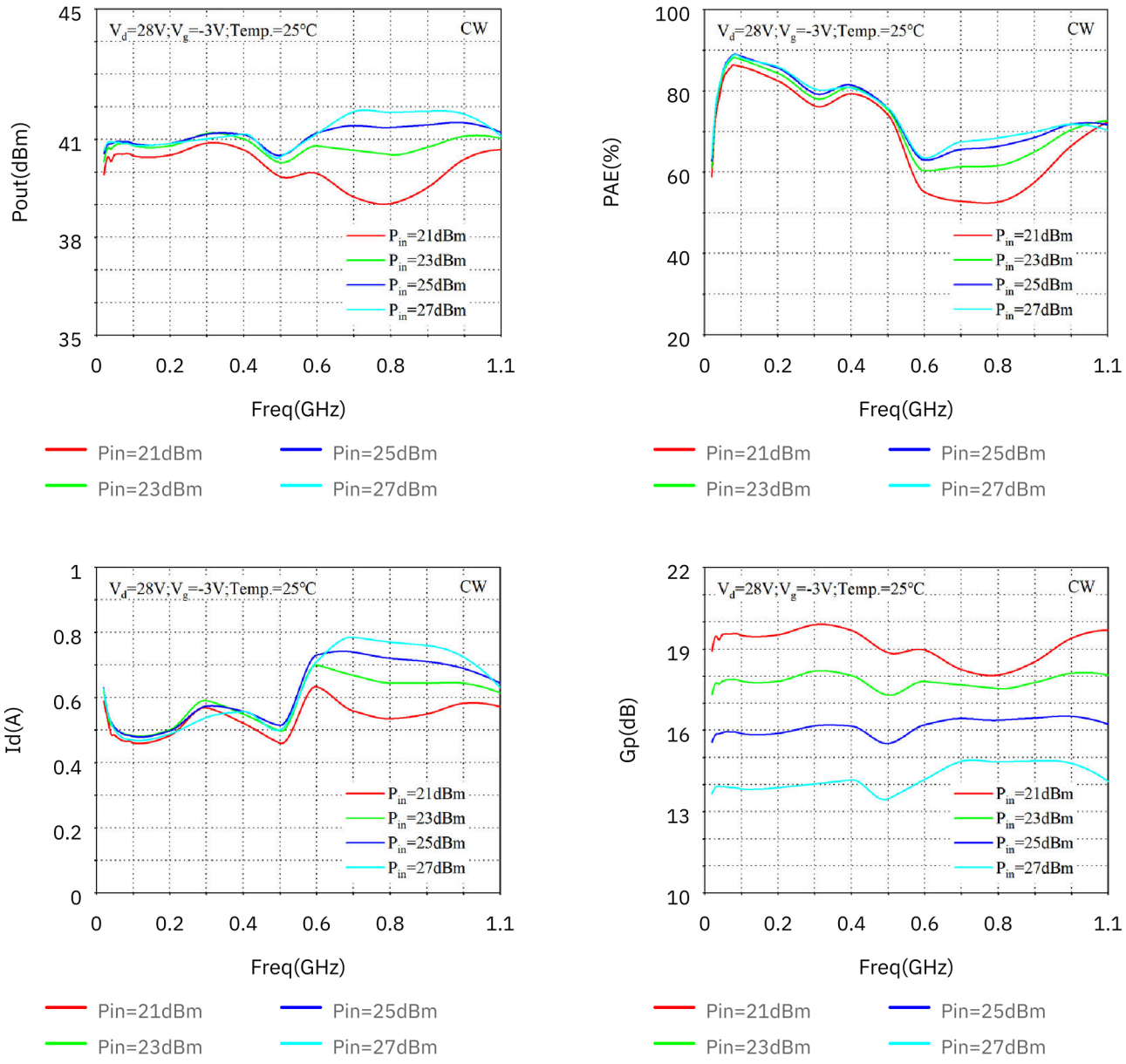
外形寸法図

確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。



性能特性曲線

各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。



出力電力、電力付加効率、ドレイン電流、電力利得。 Vd = 28 V; Vg = -3 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 21/23/25/27 dBm.

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。